# (19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平8-317639

(43)公開日 平成8年(1996)11月29日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H02M	3/28			H02M	3/28	F	
	3/338				3/338	Α	

### 審査請求 未請求 請求項の数2 書面 (全 4 頁)

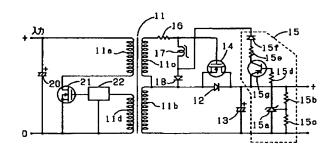
(21)出願番号	特顧平7-156632	(71)出顧人	592091057 大平電子株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)5月19日		埼玉県比企郡嵐山町大字平沢254番地72
		(72)発明者	佐藤・守男
			埼玉県比企郡嵐山町大字平沢254番地72
			大平電子株式会社内

## (54) 【発明の名称】 同期制液方式のリンギングチョークコンパータ

#### (57)【要約】

【目的】 リンギングチョークコンパータに同期整流回 路を応用することによって発振の安定と効率の向上を得

【構成】 2次整流ダイオードにMOSFETを並列接 続し、このMOSFETを駆動する補助巻線をトランス に付加し、かつMOSFETのオン期間を可飽和インダ クタを利用して制御する。



#### 【特許請求の範囲】

?

【請求項1】 1次巻線と2次巻線を有するトランスと、前記トランスの2次巻線に直列に接続されたダイオードを備えたリンギンクチョークコンバータにおいて、前記ダイオードにMOSFETを並列接続し、前記MOSFETのゲートとソースを結ぶ回路に抵抗を直列に挿入し、前記MOSFETのゲート・ソース間に可飽和インダクタとダイオードからなる直列回路を接続し、かつ出がクタとダイオードからなる直列回路を接続し、かつ出がクタに供給するリセット信号制御回路を接続したことを特徴とする同期整流方式のリンギングチョークコンバータ。

【請求項2】 前記2次巻線に直列に接続されたダイオードを削除したことを特徴とする請求項1 記載の同期整流方式のリンギングチョークコンバータ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電源装置の1つの方式であるリンギングチョークコンパータに関する。

[0002]

【従来の技術】一般的なリンギングチョークコンパータは、入出力電圧が一定の条件の下では、オン期間とオフ期間の比は一定で、出力電流の変化に対して発振周期を変えることにより出力電圧が一定に保たれている。出力電流が小さければ発振周期も短くなり、従ってオン期間もオフ期間も各々短くなる。

【0003】出力電流が最大値からゼロまで変化する負荷条件ではオン期間が広い範囲に渡って変化するが、出力電流がゼロに近づくに従って短くなり制御不能となりやすい。そのため間欠発振や過電圧発生の問題を起こすことがある。

【0004】そこで本出願人は先に2次巻線に逆方向に 電流を流すことができるリンギングチョークコンパータ を提供した(特願平6-294051)。図3はこの回 路を示すものである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】図3において巻線11 cには出力電圧に比例する電圧が発生し、この電圧がMOSFET14のスレッショルド電圧を越すと、MOSFETは2次巻線11bによるフライバック電流が放出した後も引き続きオン状態を保ち、逆にコンデンサ13の電圧が2次巻線11bに加わる。そのため2次巻線11bにはフライバック電流の方向と反対向きの電流が流れる。この電流はトランス11を逆方向に励磁する電流となる。

【0006】2次巻線11bを流れる励磁電流によって トランス11に蓄積される励磁エネルギーは1次巻線1 1aに直列に接続されているスイッチング素子21が次 のサイクルでターンオンしたときに1次巻線11aを通るフライバック電流となり、これがコンデンサ20に充電エネルギーとして戻るので損失はほとんどない。

【0007】また、2次巻線11bに流れる励磁電流は補助巻線11cの電圧がMOSFET14のスレッショルド電圧より小さくなるまで続く。そのため、出力電圧はこのスレッショルド電圧に巻線11bと11cの巻線比をかけた値にほぼ等しくなる。

【0008】このように図3に示した回路において、出力電圧はMOSFET14のスレッショルド電圧によって決まる。そのため1次巻線11aに直列に接続されているMOSFET21の制御回路22は1次巻線を流れる励磁電流の最大値またはMOSFET21の最大オン期間を制限するだけで良く出力電圧検出値によって帰還制御機能を持つ必要はない。

【0009】しかし、MOSFETがスレッショルド電 圧のごく近くでオン状態を保つためMOSFETのオン 抵抗を十分小さくすることができない。

【0010】そこで本発明は、補助巻線11cからMOSFETのゲートに加わるパルスの幅を制御することにより、出力電圧を一定に保つと同時にMOSFETのゲートに加わるパルスの振幅をスレッショルド電圧より十分高めに設定することを可能にしMOSFETのオン期間の抵抗値を小さくし効率を改善することを目的としている。

### [0011]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するため、請求項1記載の発明において、補助巻線から2次側整流ダイオードに並列接続されているMOSFETのゲート・ソース間に加わるパルスの幅を抵抗と可飽和インダクタとリセット信号制御回路によって制御する。

[0012]

【作用】請求項1の発明において可飽和インダクタが飽和するまでの期間がMOSFETのオン期間にほぼ等しく、またこのオン期間の間に2次巻線にはフライバック電流と励磁電流が流れる。

【〇〇13】可飽和インダクタに補助巻線から加わる電圧は可飽和インダクタに直列に接続されているダイオードによって一方向だけであるため、この可飽和インダクタが一度飽和すると、他の回路によってリセット信号が加えられない限り、ほぼ短絡に近い状態を維持し、補助巻線にパルス電圧が発生しても、抵抗によって降圧し、MOSFETのゲート・ソース間にスレッショルド電圧を越える電圧は加わらず、MOSFETはオン状態になり得ない。

【0014】補助巻線に直列に接続されている抵抗は、 可飽和インダクタが飽和した直後にわずかな期間ではあ るが補助巻線から可飽和インダクタに流れる突入電流を 制限する。

【〇〇15】次にこの可飽和インダクタに他の回路によ

ってリセット信号が加えられると、MOSFETもリセット信号の強さに応じた期間だけオン状態を保つ。

【0016】リセット信号の強さによってMOSFETのオン期間が制御されるので、リセット信号の強さを出力電圧検出値に応じて変えることにより出力電圧を一定に保つことができる。

【0017】請求項2の発明において、MOSFETのオン抵抗が十分小さく、2次巻線の電流によるドロップ電圧が整流ダイオードの順方向電圧より小さければ、この整流ダイオードを除くことができる。そして、過負荷時または短絡時において、補助巻線の電圧が下がった状態でMOSFETがオン状態にならない場合はMOSFETの寄生ダイオードが整流の働きをする。

#### [0018]

Ş

【実施例】図1は請求項1記載の発明の実施例を示す回路図である。従来の例を示す図3の回路と同一または同等な部分には同一の符号を与えた。

【0019】図2は請求項2記載の発明の実施例を示す 回路図である。従来の例を示す図3の回路と同一または 同等な部分には同一の符号を与えた。

【0020】図4は図1に示した回路の2次巻線11b 両端の電圧波形とMOSFET14のドレイン電流とダイオード12の電流の和の電流波形を同じ時間軸で測定 したものである。

【0021】図1の回路において、リセット信号制御回路15は出力電圧を検出し、その値が設定値より高い場合はダイオード15fより出力される電流を大きくし、またその値が設定値より低い場合はダイオード15fより出力される電流を小さくする。ダイオード15fより出力される電流は補助巻線11cの電圧がMOSFET14を逆パイアスする方向に変わったときに可飽和インダクタ17を通り、抵抗16及び補助巻線11cと2次巻線11bを通って流れる。この電流が可飽和インダクタ17をリセットする。すなわち、出力電圧が設定値より高くなるとリセット電流が大きくなる。

【0022】このリセット電流が大きいと、補助巻線11cの電圧がMOSFET14を順バイアスする方向に変わったときに、可飽和インダクタ17が補助巻線11cの電圧によって飽和に達するまでの時間が長くなり、MOSFET17のオン期間も長くなる。

【0023】MOSFET17のオン期間が長くなった分だけ2次巻線11bを逆方向に流れる励磁電流が大きくなる。この電流はコンデンサ13の放電によってまかなわれるため出力電圧は下がる。このようにして出力電圧は一定に保たれる。

【0024】図4に示したMOSFET14のドレイン 電流波形の正の部分はフライバック電流であり、負の部 分は励磁電流である。出力電流がゼロとき、これら2つ の電流の面積はほぼ半々になり、出力電流が最大のとき は、励磁電流の面積がほぼゼロになる。 【0025】フライバック電流と励磁電流の面積の合計 は出力電流がゼロから最大値まで変化する間は一定であ り、各々の期間の合計も一定である。従って発振の周期 もほぼ一定となる。

【0026】発振の周期がほぼ一定であるという点は一 般的なリンギングチョークコンパータと異なる。

【0027】図2の回路において、2次巻線に接続される整流回路はMOSFET17だけである。MOSFET17のオン抵抗が十分小さければ、コンパータの効率を上げることが可能である。

【0028】また図2の回路において、可飽和インダクタ17に供給するリセット信号を検出電圧と異なる出力電圧より得ているが、このような応用は検出電圧が比較的高いときに、リセット電流による電力損失を節約するときに有効である。

#### [0029]

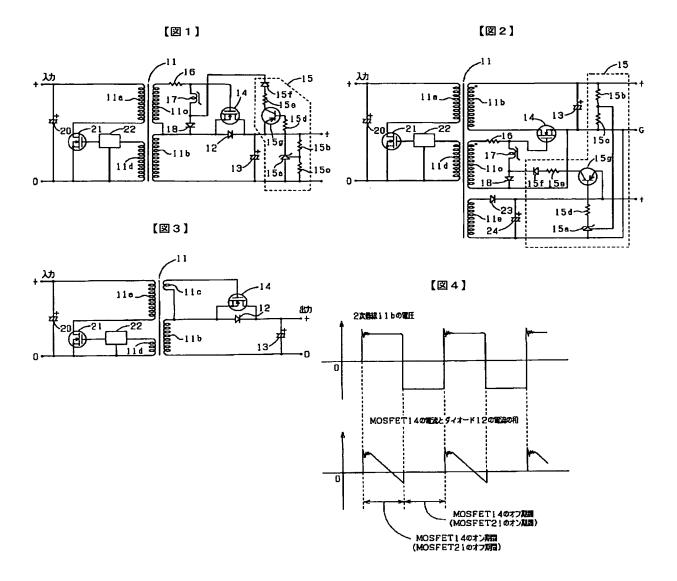
【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、発振周 波数がほぼ一定となる動作の安定した、かつ効率の高い コンバータが簡素な構成でできた。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】請求項1記載の発明の実施例である。
- 【図2】請求項2記載の発明の実施例である。
- 【図3】従来の回路図である。
- 【図4】図1に示した回路の動作波形である。

## 【符号の説明】

- 11 トランス
- 12 ダイオード
- 13 コンデンサ 14 MOSFET
- 15 リセット信号制御回路
- 16 抵抗
- 17 可飽和インダクタ
- 18 ダイオード
- 20 コンデンサ
- 21 MOSFET
- 22 ゲート制御回路
- 23 ダイオード
- 24 コンデンサ
- 11a 1次巻線
- 11b 2次巻線
- 11c 補助巻線
- 11d 正帰還巻線
- 11e 第2の2次巻線
- 15a 電圧検出用 [C
- 15 b 抵抗
- 15c 抵抗
- 15d 抵抗
- 15e 抵抗
- 15 f ダイオード
- 15g トランジスタ



.